

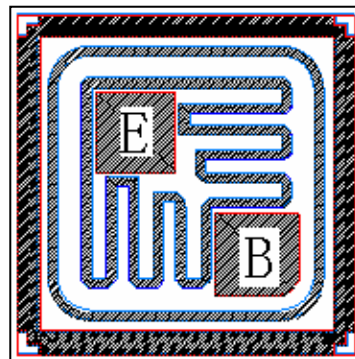


9013 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：C043BJ-00
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：430×430μm²
 焊位尺寸：B 极 107×107μm² , E 极 101×101μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：SS9013 , H9013 , 8050S

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
 T_j——结温.....150
 P_C——集电极耗散功率.....625mW
 V_{CBO}——集电极—基极电压.....40V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压.....20V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....5V
 I_C——集电极电流.....500mA

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			0.1	μA	V _{CB} =25V , I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			0.1	μA	V _{EB} =3V , I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	80		390		V _{CE} =1V , I _C =50mA
		40				V _{CE} =1V , I _C =500mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			0.6	V	I _C =500mA , I _B =50mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			1.2	V	I _C =500mA , I _B =50mA
V _{BE(on)}	基极—发射极导通电压	0.6		0.73	V	V _{CE} =1V , I _C =10mA
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	40			V	I _C =100μA , I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	20			V	I _C =1mA , I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	5			V	I _E =100μA , I _C =0